云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十 一次会议通知于 2025 年 11 月 1 日以专人送达方式发出, 并于 2025 年 11 月 6 日 以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议出席人数、 召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成 如下决议:

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于设立孙公司实施"高品 质砷化镓晶片建设项目"的议案》。

同意控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司(以下简称"云南鑫耀")与 自然人刘广政共同出资 5,000 万元设立湖北鑫耀半导体材料科技有限公司(暂定 名,以下简称"湖北鑫耀"),其中:云南鑫耀以货币资金及实物(机器设备) 的形式认缴出资 4,500 万元,刘广政先生以货币资金形式认缴出资 500 万元。

同意以控股孙公司湖北鑫耀为主体实施"高品质砷化镓晶片建设项目"。

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆 锗业股份有限公司关于设立孙公司实施高品质砷化镓晶片建设项目的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2025年11月7日